

BT136(TO-220)双向可控硅

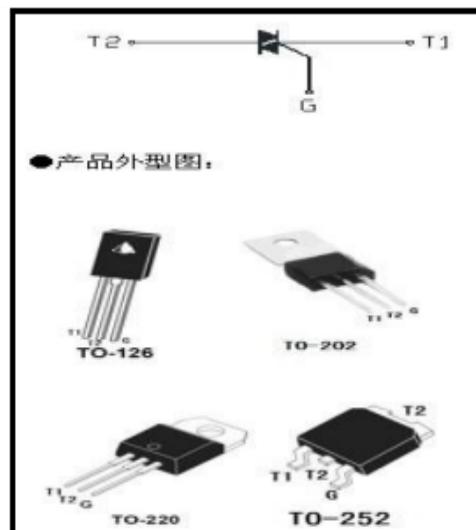
■ 特点：

先进的台面玻璃钝化工艺，具有通态压降低，门极逻辑电平触发等特点，可直接应用 IC 驱动。

■ 用途：

广泛应用于调光、调温等调压电路，微波炉、洗衣机、空调、电风扇、饮水机、夜明灯等家电的控制电路及用于交流相控、斩波器、逆变器和变频器等电路中。

■ 极限参数：



名称	符号	数值	单位	条件
重复峰值阻断电压	V_{DRM}	≥ 600	V	$I_{DRM}=20\mu A$
通态均方根电流	I_{TRMS}	4	A	所有导通角
通态浪涌电流	I_{TSM}	25	A	$t=10ms$
		27	A	$t=16.7ms$
门极峰值电流	I_{GM}	2	A	$T_f=125^\circ C$
结温范围	T_j	-40~125	°C	---
贮存温度	T_{stg}	-40~150	°C	---

■ 电特性 ($T_f=25^\circ C$) :

名 称	符 号	测 试 条 件	Min	Max	Type	单 位
正向断态峰值电流	I_{RRM}	$T_j=125^\circ C \quad V_{RRM}=V_{DRM}$	---	0.5	---	mA
通态峰值电压	V_{TM}	$I_{TM}=6A \quad t=380\mu s$	---	---	1.7	V
门极触发电流	I - II - III	$V_D=12V \quad R_L=30\Omega$	---	10	---	mA
	IV		---	25	---	mA
门极触发电压	V_{GT}	$V_D=12V \quad R_L=30\Omega$	---	1.5	---	V
门极不触发电压	V_{GD}	$V_D=V_{DRM} \quad T_j=125^\circ C$	0.2	---	---	V
断态电压临界上升率	dV/dt	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=125^\circ C$	50	---	---	V/ μs
通态电流临界上升率	dI/dt	$I_T=6A \quad I_g=0.2A \quad dI_g/dt=0.2 A/\mu s$	50	---	---	A/ μs
维持电流	I_H	$I_f=0.2A$	≤15	---	---	mA